TRANSİSTÖR

İçerik (1)

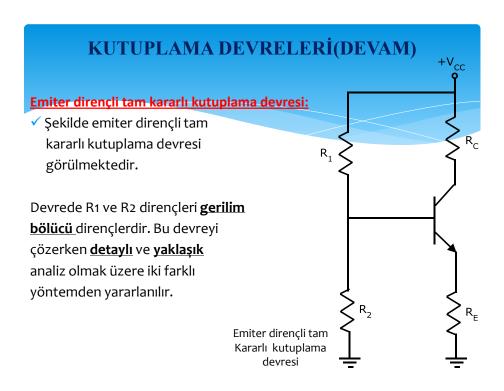
- Emiter Dirençli Tam Kararlı Kutuplama Devresi
- Ortak Kollektör Kutuplama Devresi
- Transistörün evirici olarak kullanılması
- Transistörün anahtarlama elemanı olarak kullanılması.
- Çalışma soruları



KUTUPLAMA DEVRELERİ(DEVAM)

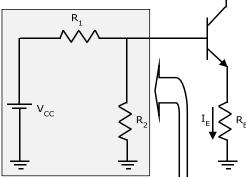
Emiter dirençli tam kararlı kutuplama devresi:

- ✓ <u>Sabit</u> ve <u>emiter dirençli sabit kutuplama</u> devrelerinin her ikisi de transistörün ß'sından etkilenmektedirler. ß, ısıyla değiştiğinden çalışma noktasının kaymasına dolayısıyla devrenin kararlığının bozulmasına neden olmaktadır.
- ✓ Bu problemi ortadan kaldırmak için ß'dan çok az etkilenen gerilim bölücü veya tam kararlı kutuplama devresi tasarlanmıştır. Devrede R1 ve R2 dirençleri gerilim bölücü dirençlerdir. Bu devreyi çözerken detaylı ve yaklaşık analiz olmak üzere iki farklı yöntemden yararlanılır.



Emiter dirençli tam kararlı kutuplama devresi (Detaylı Analiz):

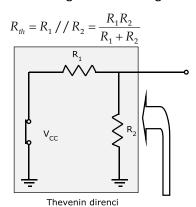
✓ Detaylı analiz gerçekleştirilirken giriş devresinin thevenin eşdeğeri bulunur. Thevenin eşdeğeri Rth ve Eth olmak üzere iki kısımdan oluşur.

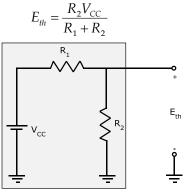


Thevenin eşdeğer devresi

Emiter dirençli tam kararlı kutuplama devresi (Detaylı Analiz):

- ✓ Boyalı kısımda kaynak kısa devre edilirse thevenin direnci Rth bulunur.
- ✓ Thevenin gerilimi Eth de gerilim bölücüden bulunur.



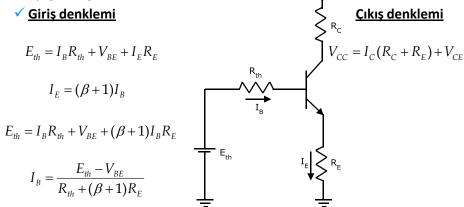


Thevenin gerilimi

KUTUPLAMA DEVRELERİ(DEVAM)

Emiter dirençli tam kararlı kutuplama devresi (Detaylı Analiz):

✓ Thevenin direnç ve gerilimleri bulunduktan sonra devrenin girişi aşağıdaki gibi olur.

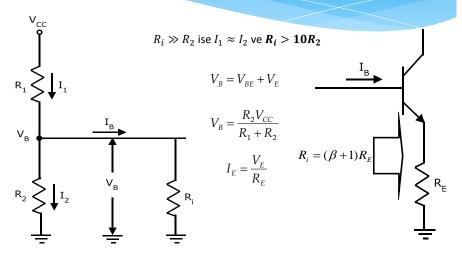


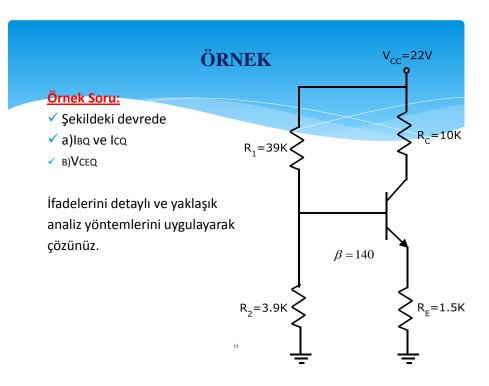
Emiter dirençli tam kararlı kutuplama devresi (Yaklaşık Analiz):

- ✓ Devrede $R_i \gg R_2$ ise $I_1 \approx I_2$ olur. Bu durumda R1 direnci üzerinden geçen I_1 akımının çok büyük bir bölümü R2 üzerinden de geçer.
- ✓ Bilindiği gibi akım az dirençli yolu tercih eder.
- ✓ Eğer transistörü giriş direnci R_i ile R_2 arasında $R_i > 10R_2$ koşulu sağlanıyorsa devre yaklaşık analizle çözülebilir. ($R_i = (\beta + 1)R_E$)

KUTUPLAMA DEVRELERİ(DEVAM)

Emiter dirençli tam kararlı kutuplama devresi (Yaklaşık Analiz):





Çözüm (detaylı analiz):

✓ Thevenin direnci ve thevenin gerilimi bulunur.

$$R_{th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{39K \cdot 3.9K}{39K + 3.9K} = 3.55K \qquad E_{th} = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2} = \frac{3.9K \cdot 22V}{39K + 3.9K} = 2V$$

✓ Giriş akımı
$$I_{B} = \frac{E_{th} - V_{BE}}{R_{th} + \beta R_{E}} = \frac{2V - 0.7V}{3.55K + 140 \cdot 1.5K} = 6.05 \mu A$$

✓ Çıkış akımı
$$I_C = \beta I_B = 140 \cdot 6.05 \,\mu A = 0.85 \,mA$$

$$\checkmark$$
 Çıkış gerilimi $V_{CC}=I_C(R_C+R_E)+V_{CE}$ ise $V_{CE}=V_{CC}-I_C(R_C+R_E)$
$$V_{CE}=22V-0.85mA(10K+1.5K)=12.22V$$

Çözüm (yaklaşık analiz):

✓ Koşul sağlanıyorsa yaklaşık analiz yapılır.

$$(\beta+1)R_F \ge 10R_F$$

$$(\beta+1)R_F \ge 10R_2$$
 $(140+1)1.5 \ge 10 \cdot 3.3K_2$

 $210K \ge 39K$

✓ Koşul sağlandığından yaklaşık analiz yapılabilir.

$$V_B = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2} = \frac{3.9K \cdot 22V}{39K + 3.9K} = 2V$$

$$\checkmark$$
 $V_B = V_{BE} + V_E$

$$\checkmark$$
 $V_B = V_{BE} + V_E$ ise $2V = 0.7V + V_E$ ise $V_E = 1.3V$

Yukarıdaki ifadeden çıkış akımı
$$I_E \cong I_C = \frac{V_E}{R_E} = \frac{1.3V}{1.5K} = 0.867 mA$$

Çıkış gerilimi
$$V_{CE} = 22V - 0.867 \,\mu\text{A} (10K + 1.5K) = 12.03V$$

ÖRNEK (DEVAM)

Çözüm (detaylı ve yaklaşık analizin karşılaştırılması):

✓ Şimdi detaylı ve yaklaşık analizden elde ettiğimiz sonuçları karşılaştıralım. Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere sonuçlar bir birine çok yakın çıkmıştır

	I_{CQ}	V_{CEQ}
Detaylı analiz	0.85mA	12.22V
Yaklaşık analiz	0.867mA	12.03V

Çözüm (β değeri yarıya indirilirse):

- ✓ Gerilim bölücü kutuplama yönteminin kararlılığını ölçmek için aynı örnekte β değerini yarıya indirelim ($\beta = 70$) alalım.
- ✓ Devrede $R_{th} = 3.55 K$ ve $E_{th} = 2V$ bulunmuştu.

✓ Giriş akımı
$$I_B = \frac{E_{th} - V_{BE}}{R_{th} + \beta R_E} = \frac{2V - 0.7V}{3.55K + 70 \cdot 1.5K} = 11.8 \mu A$$

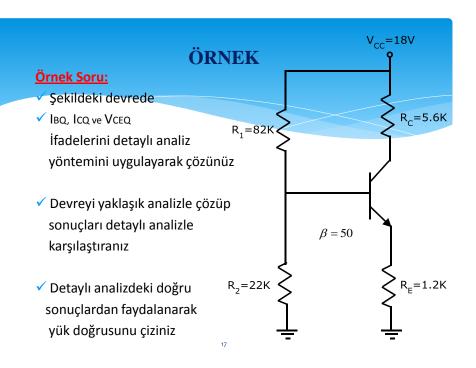
- ✓ Çıkış akımı $I_C = βI_B = 70 \cdot 11.8 μA = 0.83 mA$
- ✓ Çıkış gerilimi $V_{CE} = 22V 0.83 \mu A (10K + 1.5K) = 12.46V$

ÖRNEK (DEVAM)

Çözüm (detaylı ve yaklaşık analizin karşılaştırılması):

Şimdi $\beta=140$ ve $\beta=70$ 'ten elde edilen sonuçlar karşılaştırılınca, sonuçların bir birine çok yakın çıktığı görülür. β değeri yarıya inmesine rağmen çıkış akımı ve çıkış gerilimi yanı çalışma noktası çok ama çok küçük bir miktar değişmiştir. Buradan **Emiter Dirençli Tam Kararlı Kutuplama Devresinin** gerçekten de kararlı bir yapıya sahip olduğu ortaya çıkmaktadır.

	I_{CQ}	V_{CEQ}
$\beta = 140$	0.85mA	12.22V
$\beta = 70$	0.83mA	12.46V



Çözüm (detaylı analiz):

✓ Thevenin direnci ve thevenin gerilimi bulunur.

$$R_{th} = \frac{82K \cdot 22K}{82K + 22K} = 17.35K \quad E_{th} = \frac{22K \cdot 18V}{82K + 22K} = 3.81V$$

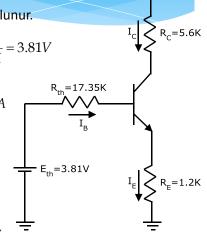
✓ Giriş akımı
$$I_{B} = \frac{E_{th} - V_{BE}}{R_{th} + \beta R_{E}} = \frac{3.81V - 0.7V}{17.35K + 50 \cdot 1.2K} = 39.6 \mu A$$

✓ Çıkış akımı

$$I_{C} = \beta I_{B} = 50 \cdot 39.6 \,\mu A = 1.98 mA$$

✓ Çıkış gerilimi

$$V_{CE} = 18V - 1.98mA(5.6K + 1.2K) = 4.54V$$



Çözüm (yaklaşık analiz):

√ Koşul sağlanıyorsa yaklaşık analiz yapılır.

$$(\beta+1)R_F \ge 10R$$
, $(150+1)1.2K \ge 10x22K$, $60K \ge 220K$

- ✓ Koşul sağlanmamaktadır. Fakat yaklaşık analiz yanlış uygulandığında akım ve gerilimde oluşacak hatayı gözlemek için aynı örneği bir de yaklaşık analizle çözelim. Rth ve Eth değişmez. $R_{th}=17.35K$ $E_{th}=3.81V$
- $V_B = V_{BE} + V_E$ ise $3.81V = 0.7V + V_E$ ise $V_E = 3.11V$

Yukarıdaki ifadeden çıkış akımı $I_E \cong I_C = \frac{V_E}{R_F} = \frac{3.11V}{1.2K} = 2.59mA$

Çıkış gerilimi $V_{CE} = 18V - 2.59mA(5.6K + 1.2K) = 0.376V$

ÖRNEK (DEVAM)

Çözüm (detaylı ve yaklaşık analizin karşılaştırılması):

✓ Şimdi detaylı ve yaklaşık analizden elde ettiğimiz sonuçları karşılaştıralım. Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere koşul sağlanmadığı için sonuçlar bir birinden çok farklı çıkmıştır.

	I_{CQ}	V_{CEQ}
Detaylı analiz	1.98mA	4.54V
Yaklaşık analiz	2.59mA	0.376V

Çözüm:

 Detaylı analizdeki doğru sonuçlardan faydalanarak yük doğrusunu çizelim. Öncelikle doyum akımı ve kesim gerilimini bulalım.

$$V_{CE}=0~ise$$

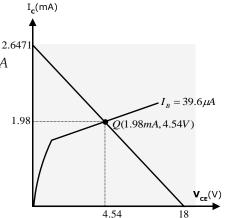
$$I_{Cdoy}=\frac{V_{CC}}{R_C+R_E}=\frac{18V}{5.6K+1.2K}=2.6471mA$$

$$I_C=0~ise~V_{CEkesim}=V_{CC}=18V$$
 Çalışma noktasının elemanları

Çalışma noktasının elemanlar olan Icq ve VcEq daha önce bulunmuştu.

$$I_{BQ} = 39.6 \,\mu A \quad I_{CQ} = 1.98 mA$$

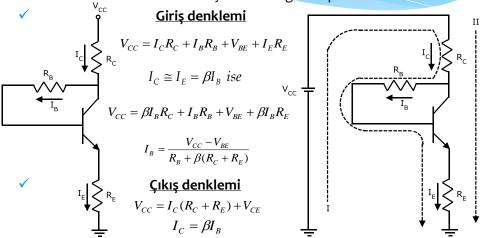
$$V_{CEQ} = 4.54 V$$



KUTUPLAMA DEVRELERİ(DEVAM)

Geri-beslemeli Kutuplama Devresi:

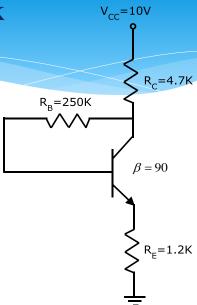
Geri beslemeli kutuplama devresi gerilim bölücü dirençli kutuplama kadar olmasa da belli bir düzeyde kararlılığa sahiptir.



ÖRNEK

Örnek Soru:

- Şekildeki devrenin yük doğrusunu çizip çalışma noktasını bulunuz.
- ✓ Aynı devrede ß=135 alarak Icq ve VcEq değerlerini bulup, ß=90'daki sonuçlarla karşılaştırınız.



23

ÖRNEK (DEVAM)

Çözüm:

✓ Öncelikle yük doğrusunun elemanlarını bulalım.

$$I_C=0~ise~V_{CEkesim}=V_{CC}=10V$$

$$V_{CE}=0~ise~I_{Cdoyum}=\frac{V_{CC}}{R_C+R_E}=\frac{10V}{4.7K+1.2K}=1.6949mA$$

Çalışma noktasını bulmak için önce IBQ giriş ve sonra ICQ çıkış akımı bulunur.

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta (R_C + R_E)} = \frac{10V - 0.7V}{250K + 90(4.7K + 1.2K)} = 11.91\mu A$$

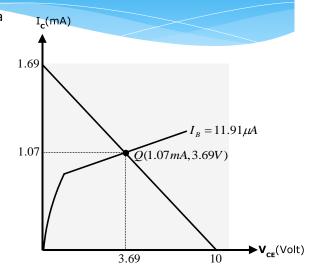
$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 90 \cdot 11.91\mu A = 1.07mA$$

Denklem 2'den çıkış gerilimini bulunur.

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E) = 10V - 1.07 mA(4.7K + 1.2K) = 3.69V$$

Çözüm:

 Yük doğrusu ve çalışma noktası yandaki gibidir.



ÖRNEK (DEVAM)

Çözüm (β değeri yarıya indirilirse):

✓ Geri beslemeli kutuplama devresinin kararlılığını ölçmek için aynı örnekte $\beta=135$ alalım.

✓ Giriş akımı
$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta (R_C + R_E)} = \frac{10V - 0.7V}{250K + 135(4.7K + 1.2K)} = 8.89 \,\mu\text{A}$$

$$\checkmark$$
 Çıkış akımı $I_C = \beta I_B = 135 \cdot 8.89 \,\mu A = 1.2 \,mA$

$$\checkmark$$
 Çıkış gerilimi $V_{CEQ}=10V-1.2mA(4.7K+1.2K)=2.9V$

Çözüm ($\beta = 90$ ve $\beta = 135$ sonuçlarının karşılaştırılması):

- ✓ Şimdi $\beta=90$ ve $\beta=135$ 'ten elde ettiğimiz sonuçları karşılaştıralım.
- Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi β'nın değerinin %50 artırılması lcq'nun %12.1 artmasına Vcεq'nun ise %20.9 azalmasına neden olmuştur. Aynı değişim sabit kutuplama devresinde yapılsaydı, akım ve gerilimdeki değişim %50 olacaktı. Buradan geri beslemeli kutuplamanın sabit kutuplamadan iyi fakat emiter dirençli tam kararlı kutuplama devresinden kötü sonuç verdiği görülmektedir.

	I_{CQ}	V_{CEQ}
$\beta = 90$	1.07mA	3.69V
$\beta = 135$	1.2mA	2.9V

KUTUPLAMA DEVRELERİ(DEVAM)

Ortak Kollektör Kutuplama devresi:

✓ Ortak kollektör kutuplama devresinde giriş VcB'den uygulanır çıkış ise VcE'den alınır. Bu kutuplama yöntemi özellikle empedans uygunlaştırma işleminde kullanılır. Bu devrenin yüksek giriş empedansına rağmen küçük çıkış empedansı vardır. Ortak base ve ortak emiterli devrede ise durum tam tersidir: düşük giriş, yüksek çıkış empedansı mevcuttur.

Ortak Kollektör Kutuplama devresi:

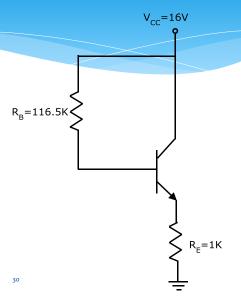


NPN ve PNP transistörün ortak kollektör kutuplama devreleri

ÖRNEK

Örnek Soru:

 Şekildeki ortak kollektör devrenin yük doğrusunu çizip çalışma noktasını bulunuz (β = 120).



Çözüm:

✓ Öncelikle yük doğrusunun elemanlarını bulalım.

$$I_C = 0$$
 ise $V_{CEkesim} = V_{CC} = 16V$

$$V_{CE} = 0$$
 ise $I_{Edoyum} = \frac{V_{CC}}{R_E} = \frac{16V}{1K} = 16mA$

✓ Çalışma noktasını bulmak için önce IBQ giriş ve sonra IEQ çıkış akımı bulunur.

$$I_{_{BQ}} = \frac{V_{_{CC}} - V_{_{BE}}}{R_{_B} + \beta R_{_E}} = \frac{16V - 0.7V}{116.5K + 120 \cdot 1K} = 66.1 \mu A \qquad I_{_{EQ}} = \beta I_{_{BQ}} = 120 \cdot 66.1 \mu A = 8mA$$

✓ Çıkış gerilimi aşağıdaki gibi bulunur.

$$V_{CEO} = V_{CC} - I_E R_E = 16V - 8mA \cdot 1K = 8V$$

ÖRNEK (DEVAM)

Çözüm:

 Yük doğrusu ve çalışma noktası yandaki gibidir.

